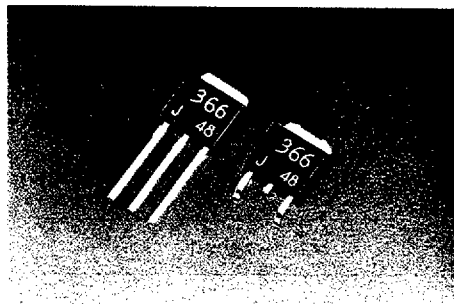


60Vシリーズ パワー-MOSFET 60V SERIES POWER MOSFET

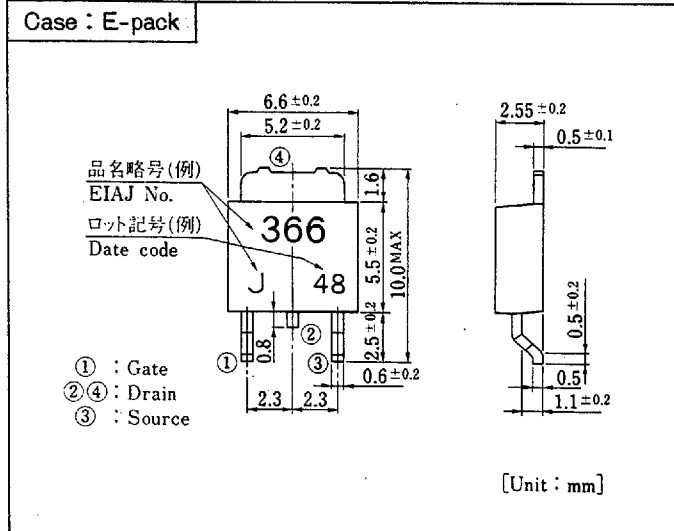
高速スイッチング
P-チャネル エンハンスメント型

2SJ366
(F5E6P)

-60V -5A



外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS



定格表 RATINGS

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings

項 目 Item	記 号 Symbol	条 件 Conditions	規 格 値 Ratings	単 位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg		-55~150	°C
チャネル温度 Channel Temperature	Tch		150	°C
ドレイン・ソース電圧 Drain-Source Voltage	V _{DSS}		-60	V
ゲート・ソース電圧 Gate-Source Voltage	V _{GSS}		±20	V
ドレイン電流 Continuous Drain Current	DC	I _D	-5	A
	Peak	I _{DP}	パルス幅 ≤ 10μs, duty ≤ 1/100 Pulse width ≤ 10μs, Duty cycle ≤ 1/100	A
ソース電流(直流) Continuous Source Current (DC)	I _S		-5	A
全損失 Total Power Dissipation	P _T	T _C =25°C	25	W
アバランシェ電流 Avalanche Current	I _{DA}	T _C =25°C	-5	A

電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (T_C=25°C)

項 目 Item	記 号 Symbol	条 件 Conditions	規格値 Ratings			単 位 Unit
			min.	typ.	max.	
ドレイン・ソース降伏電圧 Drain-Source Breakdown Voltage	V _(BR) DSS	I _D =-1mA, V _{GS} =0V	-60			V
ドレイン遮断電流 Zero Gate Voltage Drain Current	I _{DSS}	V _{DS} =-60V, V _{GS} =0V			-100	μA
ゲート漏れ電流 Gate-Source Leakage Current	I _{GSS}	V _{GS} =±20V, V _{DS} =0V			±10	μA
順伝達コンダクタンス Forward Transconductance	g _{fs}	I _D =-2.5A, V _{DS} =-10V	2.8	4.0		S
ドレイン・ソース間オン抵抗 Static Drain-Source On-state Resistance	R _{DS(ON)}	I _D =-2.5A, V _{GS} =-10V		0.15	0.25	Ω
ゲートしきい値電圧 Gate Threshold Voltage	V _{TH}	I _D =-1mA, V _{DS} =-10V	-1.0	-1.5	-2.0	V
ソース・ドレイン間ダイオード順電圧 Source-Drain Diode Forward Voltage	V _{SD}	I _S =-2.5A, V _{GS} =0V			-1.5	V
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jc}	接合部・ケース間 Junction to case			5.0	°C/W
ゲートチャージ特性 Gate Charge Characteristics	Q _g	V _{GS} =-10V, I _D =-5A, V _{DD} =-48V		-27		nC
入力容量 Input Capacitance	C _{iss}	V _{DS} =-10V, V _{GS} =0V, f=1MHz		630		pF
帰還容量 Reverse Transfer Capacitance	C _{rss}			150		
出力容量 Output Capacitance	C _{oss}			340		
ターンオン時間 Turn-on Time	t _{on}	I _D =-2.5A, V _{GS} =-10V, R _L =12Ω		55	110	ns
ターンオフ時間 Turn-off Time	t _{off}			260	520	

8219387 0002215 790

Shindengen TOKYO, JAPAN.

■ 特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS

